

国信证券股份有限公司
关于深圳市路维光电股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》（以下简称“《自律监管指引第 11 号》”）等相关规定，负责路维光电在可转换公司债券及向特定对象发行的股票上市后的持续督导工作，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。

序号	工作内容	实施情况
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于 2026 年 6 月 12 日对上市公司进行了 2026 年上半年募集资金现场核查。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促路维光电依照相关规定严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对路维光电的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，路维光电的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证上市公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促路维光电严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对路维光电的信息披露文件进行了审阅，不存在因文件存在问题、上市公司不予更正或补充而应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。

序号	工作内容	实施情况
12	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，路维光电未出现应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情形。
14	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，路维光电及相关主体未出现需要做出说明、改正并向交易所报告的情形。
15	在持续督导期间出现以下情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促上市公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，路维光电不存在需要进行专项现场核查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、部分产品技术指标较国际厂商存在差距

国内掩膜版产品起步较晚，与国外巨头存在一定的技术差距。在技术指标方面，公司平板显示掩膜版的精度已达到国际主流水平，经过多年技术积累和自主创新，公司具备 G2.5-G11 全世代掩膜版产品生产能力，可配套平板显示厂商所有世代产线；半导体掩膜版的精度尚处于国内主流水平，公司已实现 130nm 制程节点半导体掩膜版量产，满足适配先进芯片封装、MEMS 传感器、射频芯片等应用需求。在晶圆制造用掩膜版领域，国内独立第三方掩膜版厂商的技术能力主要集中在 130nm 制程节点以上，与国际上达到先进制程水平的领先企业有较为明显的差距；在 IC 封装和 IC 器件领域，受限于光刻、制程等工艺方式，精度方面与国际厂商亦存在一定差距。

2、关键技术人才流失风险

公司所处行业中关键技术人才的培养和维护是竞争优势的主要来源之一。行业技术人才需要长期积累，深入了解下游行业技术发展方向和产品需求，从而加深对掩膜版工艺技术的理解和把握。掩膜版行业的专业人才相对稀缺。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发技术人员 79 人，占总人数的 19.17%。随着公司业务规模的拓展、募投项目的实施，公司计划招募更多人才，进一步提高产品研发和技术创新能力，而随着行业竞争格局的变化，掩膜版行业对技术人才的争夺将日趋激烈。若公司不能保持和提升对技术人才的吸引力，核心人才出现流失，或不能适时搭建起与发展规划相匹配的研发技术队伍，将难以持续发挥人才优势，对公司的生产经营造成重大不利影响。

3、技术替代风险

公司所处的掩膜版行业属于技术密集型行业，需要深入理解下游客户的技术需求并生产出定制化的掩膜版产品，在光阻涂布、激光光刻、显影、蚀刻、脱膜、清洗、缺陷处理等主要生产环节需要积累大量的工艺经验，不断进行技术攻关。为确保公司在掩膜版核心技术领域的优势，公司不断加大研发投入，以实现技术、工艺、产品的升级。如果未来行业核心技术相关领域出现突破性技术进展时，公司未能准确判断和及时跟进新技术的发展趋势，并投入充足的研发力量布局新产品、新技术研发，公司产品可能面临被新技术替代的风险。

同时，目前全球范围内平板显示、半导体等行业基本都采用掩膜版作为基准

图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度及效率较低，主要用于电路板行业。随着科学研究的进步，不排除掩膜版行业出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风险。

（二）经营风险

1、重资产经营风险

掩膜版行业为资本密集型行业，生产设备等固定成本投入较大。2026 年上半年，随着经营规模扩大和产品结构升级，截至 2026 年 6 月 30 日，机器设备原值达到 135,286.91 万元，目前资产使用情况良好，核心设备产能利用率逐步提高。

如果未来出现市场竞争格局变化、下游客户需求减少等情形，可能导致公司产品销售规模增长乏力；若未来募投项目无法达到预期收益，新增的固定资产折旧侵蚀利润，则对经营业绩产生负面影响。

2、主要原材料和设备依赖进口且供应商较为集中的风险

公司的主要原材料采购相对集中，尤其是高世代石英基板及光学膜的供应商集中于日本、韩国，目前国内仅有部分供应商可提供少量配合，原材料存在一定的进口依赖。2026 年上半年，公司向前五大供应商采购原材料的金额为 25,174.22 万元，占原材料采购比例为 86.02%。掩膜版行业的主要生产设备光刻机亦均为境外供应，且供应商集中度较高。

未来如果主要供应商的经营状况、业务模式、交付能力等发生重大不利变化，短期内将对公司的正常经营造成负面影响；若进口国或地区开展贸易保护政策，限制出口或制造贸易摩擦，公司不能及时采购到掩膜基板及核心生产设备等，将会对公司持续生产经营产生重大不利影响。

3、主要客户相对集中的风险

2026 年上半年，公司向前五大客户合计销售金额为 49,951.61 万元，占当期营业收入的比例为 74.77%。公司的客户集中度较高，主要由于下游平板显示行业核心厂商较为集中所致。如果未来公司主要客户的经营状况出现不利变化或对公司产品需求下降，将会对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

随着公司经营规模不断扩大，公司应收款项也相应增长。截至 2026 年 6 月 30 日，应收账款账面价值为 31,387.78 万元，占期末流动资产的比例为 24.70%。

公司主要客户均为行业内知名公司，信用情况良好，各期末应收账款账龄结构基本符合公司的信用政策，规模相对于收入增速保持一致，应收账款余额快速增长具有合理性。2026 年 1-6 月，公司对应收账款按信用政策计提了坏账准备。

如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险；若客户信用风险集中发生，将会对公司营业利润产生不利影响。

2、存货跌价风险

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存货净额为 21,278.39 万元，占期末流动资产的比例为 16.75%。公司主要根据客户订单进行生产，按生产计划备料，主要原材料掩膜基板价值较高，周转速度较快。截至 2026 年 6 月 30 日，公司主要对库存商品、发出商品、原材料、委托加工物资等计提了跌价准备，计提比例为 1.52%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或因公司质量控制缺陷等因素导致出现亏损合同、销售退回产品报废、原材料积压等情况，将造成公司存货跌价损失增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争风险

目前掩膜版行业竞争对手主要系国际厂商，行业集中程度较高，公司长期直面国外掩膜版厂商的激烈竞争。经过努力追赶，公司现阶段已与国际领先企业在产品布局、产品性能等方面差距逐步缩小，但市场份额和技术实力仍然存在一定差距。随着平板显示、半导体等产业的快速发展，掩膜版市场需求持续旺盛，同时下游产业正加速向中国大陆转移，掀起产业链进口替代浪潮，国内掩膜版厂商以此为契机发展迅速。若国际主要竞争对手未来为了保持市场份额而加大对中国大陆市场的重视与投入、国内主要竞争对手为取得市场份额而采取价格竞争等手段，将导致行业竞争加剧，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、未能及时跟随下游需求变化的风险

公司目前产品主要应用于平板显示、半导体等行业。随着该等行业的快速发展，且正在加速向中国大陆转移，在消费市场和商用市场双双加持下，公司下游产业可能出现结构性调整促使细分领域对掩膜版需求的变化，若公司不能迅速把握行业发展变化，将会对公司的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。

（五）宏观环境风险

1、汇率波动的风险

公司设备及原材料采购主要采用美元及日元进行结算。随着产销规模的扩大，公司将新增设备购置，原材料进口金额亦持续增加，外汇结算量增多。随着人民币汇率日趋市场化，如果未来汇率发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

2、企业税收优惠风险

公司于 2025 年 3 月通过高新技术企业复审取得新的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202444201888，有效期为三年，税收优惠期为 2024 年至 2026 年；成都路维于 2025 年 12 月通过高新技术企业复审取得新的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202551001107，税收优惠期为 2025 年至 2027 年减按 15% 的税率征收企业所得税；成都路维、路维科技适用三部委（2020）23 号《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，减按 15% 的税率征收企业所得税。

如果公司及子公司不能持续获得高新技术企业认定或者在高新技术企业资质有效期届满后，高新技术企业评定标准出现重大变化，或者高新技术企业的税收优惠政策未来出现重大调整，则公司及子公司有可能不再享受所得税优惠，对公司的盈利能力构成不利影响。

四、重大违规事项

2026 年上半年，路维光电不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年上半年，路维光电主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	668,072,048.95	544,027,627.85	22.80
归属于上市公司股东的净利润 （元）	144,550,912.95	106,429,768.86	35.82
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	136,224,120.96	95,039,378.93	43.33
经营活动产生的现金流量净额 （元）	248,892,369.46	266,605,420.31	-6.64
	2026 年 6 月末	2025 年 12 月末	本期末比上年度 末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,730,479,872.80	1,661,683,461.64	4.14
总资产（元）	3,333,670,716.71	3,126,612,254.42	6.62

主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期 增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.75	0.55	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.55	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.71	0.49	44.90
加权平均净资产收益率 （%）	8.39	7.41	增加0.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	7.91	6.62	增加1.29个百分点
研发投入占营业收入的比例 （%）	3.82	3.31	增加0.51个百分点

2026 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长幅度较大，主要系营业收入增长，叠加规模效应释放与产品结构持续优化，同时公司持续强化运营管理，盈利能力得以加强。

六、核心竞争力的变化情况

1、领先且持续迭代的技术能力

自成立以来，公司始终将掩膜版研发作为核心主轴，在平板显示与半导体两大战略方向上持续构筑技术纵深。

在平板显示领域，公司以 2019 年 G11 掩膜版的国内首发量产为标志，成为全球第四家、国内独家掌握该世代制造技术的企业，也是本土唯一能完整配套 G2.5 至 G11 全世代面板产线的掩膜版供应商。依托 G11 产线的技术势能，公司先后将高世代半色调、灰阶掩膜版及相移掩膜版等高端品类推向市场，逐一打破海外厂商的长期供给垄断，产品技术指标对齐国际前沿水平。在 LTPO、Micro-LED、硅基 OLED 等新型显示赛道，公司各产品线均已进入量产阶段，技术能力位居前列。与此同时，公司向上游延伸突破，已掌握光阻涂布、涂布洗边与 Mura 控制等多项核心工艺，补上了本土产业链在关键材料环节的短板。围绕 AMOLED 这一高速增长市场，公司已构建起覆盖 G8.6 及以下 AMOLED 掩膜版制造、高 PPI 光刻补偿与缺陷检测、半色调掩膜版制造、相移掩膜版制造、大尺寸涂胶缺陷与 Mura 控制及 FMM 用掩膜版制造等全流程核心技术集群。

在半导体领域，公司明确将第三代半导体和先进封装作为主要发力点，面向功率器件、射频芯片、MEMS 传感器、光模块等增量市场不断拓展产品边界。工艺层面，公司在稳固激光直写、湿法制程、光学检测等成熟能力的基础上，向电

子束直写、干法制程、等离子束修补及半导体用相移掩膜版制造等更高阶工艺发起冲击，并布局光波导、衍射光学、光刻仿真模拟、反演光刻等前沿技术。伴随技术能力的梯次升级，公司正持续提升 150nm/130nm 及以下节点的产出比重，同步扩大在 AI 产业、智能装备、信息通信、新能源汽车、近眼显示等新兴终端的客户版图，为半导体掩膜版的长期增长打开更广阔的空间。路芯半导体掩膜版项目进展顺利，2025 年已逐步实现产品量产，一期实现 90nm 及以上成套掩膜版客户端验证通过并供货，40nm 和 28nm 单片掩膜版客户端验证通过并供货，并持续推进 40nm 成套掩膜版客户端送样工作；二期布局至 14nm 半导体掩膜版，计划于 2026 年陆续投建，致力于打破境外企业在高端制程领域的垄断。

2、深度协同产业演进的前瞻性综合能力

公司深耕行业近三十年，亲历并推动了国内掩膜版产业从追赶到并跑的历程。公司不仅积累了覆盖图档设计处理、光刻、检测与检验、修补的全流程制造 know-how，更形成了对下游面板行业世代更迭与半导体技术路线变迁的深刻洞察。这使得公司能够前瞻性地进行研发投入与产能规划，精准匹配下游客户的技术升级节奏。在与行业领先面板厂、晶圆厂、封测厂及芯片设计公司的长期紧密合作中，公司锻炼出快速响应多样化、定制化需求的能力，成为客户在推动产品创新与产能爬坡过程中值得信赖的合作伙伴。

3、体系化与前瞻性并重的强大研发实力

作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司已构建起覆盖产品制造与核心工艺两大维度的完整技术体系。产品制造层面，涵盖 G11 及以下 TFT 掩膜版、多灰阶掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版、AMOLED 掩膜版、平板显示相移掩膜版、130nm 制程节点半导体掩膜版、先进封装掩膜版等全品类；核心工艺层面，贯通了光阻涂布、Mura 检查与控制、高精度图形清洗缺陷控制、半导体精细化光刻控制、条纹控制、OPC 补偿等关键制程能力，广泛服务于平板显示与半导体领域。公司坚持研发驱动，已形成系统化、规范化、科学化的研发管理体系，汇聚了一支经验丰富、技术精湛的专业研发团队，核心成员普遍具备多年的项目实践积淀与深厚的专业素养，为技术持续迭代提供了坚实的人才底座。近年来，公司多次承担国家及省市政府部门的技术改造、技术攻关等科研项目，“高精度 G8.5 灰阶掩膜版研发项目”纳入四川省科技计划重点研发专项。同时，公司产品也屡获行业殊荣，公司的“G11 光掩膜版项目”于 2020 年 8 月被中国电子材料行业

协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合授予“2019 年中国新型显示行业产业链突出贡献奖”；同时，G11 和 G8.5 掩膜版分别获得 2022 年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定；G8.6TFT 用光掩膜版、CF 用光掩膜版分别获得 2024 年度四川省新材料国内首批次产品认定；公司的“G6 TFT-LCD 用相移掩膜版项目”被中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会和电子化工新材料产业联盟联合授予“2024 年度新型显示产业链创新突破奖”；半色调（half-tone）掩膜版荣获 DIC WXPO2025 “显示材料创新金奖”；LTPS 用光掩膜版入选四川省新材料“国内首批次”产品名单；显示用高世代光掩膜版为公司斩获“广东省制造业单项冠军企业”称号，彰显了公司卓越的市场地位与技术影响力。

4、稳固并持续拓展的优质客户生态

掩膜版直接定义了下游产品的良率，这一属性决定了客户对供应商的甄选极为审慎——从技术验证到批量导入，往往需经历漫长而严苛的认证周期，一旦达成合作便形成高度粘性。路维光电历经市场淬炼，已跻身掩膜版行业知名供应商行列，凭借领先的技术实力、稳定的品质交付与高效的服务响应，赢得了下游头部客户的充分信赖，与众多标杆企业缔结了长期稳固的合作纽带。在平板显示领域，公司与京东方、TCL 华星、天马微电子等全球主流显示面板企业均建立了深度、稳定的战略供应关系。在半导体领域，公司的客户群从原有的某领先芯片公司及其配套供应商、某三维多芯片集成（2.5D/3D）、宁波中芯、华天科技、晶方科技、通富微电等厂商，持续向下游芯片制造与设计环节延伸，成功导入国内几家知名光刻机研发厂商及众多国内领先的芯片公司。基于深度互信的合作关系，构成了公司业务持续增长的坚实基础，并为公司切入更先进技术赛道提供了宝贵的市场入口和反馈闭环。

综上所述，2026 年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、核心技术与研发进展

（一）核心技术及其先进性以及 2026 年上半年的变化情况

公司通过自主研发不断实现产品能力的提升及工艺技术水平提升。2026 年 1-6 月，公司新增 3 项核心工艺技术，现共拥有 56 项核心工艺技术，具体情况如下：

序号	划分维度	核心技术	技术内容	在主要产品中的应用情况	技术来源	知识产权保护情况
1	产 品 制 造 技术	G11 及 以 下 TFT(a-Si)掩膜版制造技术	最小图形可达 3 μ m,线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.25\mu$ m 以内; 总长 (TP) 及位置 (Position) 精度可控制在 $\pm 0.5\mu$ m 以内, 产品缺陷尺寸可控制在 1.0 μ m 以内。	G11 及以下尺寸 a-Si TFT 显示面板用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
2	产 品 制 造 技术	G11 及以下平板显示用多灰阶 (Multi-tone) 掩膜版制造技术	包含半色调及灰阶掩膜版, 线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.10\mu$ m 以内; 总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.5\mu$ m 以内, 两层图形之间套合偏差 (Overlay Shift) 可控制在 $\pm 0.5\mu$ m 以内, 半色调层透过率均匀性可控制在 2.0%以内。	G11 及以下尺寸平板显示用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
3	产 品 制 造 技术	G6 及 以 下 AMOLED 掩膜版制造技术	最小图形可达 1.2 μ m, 精度及均匀性高, 线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.1\mu$ m 以内, 均匀性可控制在 80nm 以内; 位置 (Position) 及总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.2\mu$ m 以内, 产品缺陷尺寸可控制在 0.75 μ m 以内。	G6 及以下 AMOLED 显示面板用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
4	产 品 制 造 技术	150nm 节点半导体掩膜版制造技术	线/间 (CD) 精度可控制在 ± 50 nm 以内; 总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.2\mu$ m 以内。	150nm 节点及第三代半导体用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
5	产 品 制 造 技术	G6 及 以 下 LTPS 掩膜版制造技术	最小图形可达 1.5 μ m,线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.1\mu$ m 以内, 均匀性可控制在 100nm 以内; 位置 (Position) 及总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.30\mu$ m 以内, 产品缺陷尺寸可控制在 1.0 μ m 以内。	G6 及以下 LTPS 显示面板用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
6	产 品 制 造 技术	先进半导体封装及指纹模组封装用掩膜版制造技术	线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.1\mu$ m 以内, 总长 (TP) 精度可以控制在 $\pm 0.2\mu$ m 以内, 产品缺陷尺寸可控制在 1.0 μ m 以内。	半导体、指纹模组等封装用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
7	产 品 制 造 技术	高精度蓝宝石衬底 (PSS) 用掩膜版制造技术	线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.1\mu$ m,总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.15\mu$ m 以内, 允许缺陷尺寸 $\leq 1.0\mu$ m。	PSS 蓝宝石衬底用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
8	产 品 制 造 技术	G5.5 及 以 下 Metal Mesh 掩膜版制造技术	线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.3\mu$ m,总长 (TP) 精度可控制在 $\pm 0.75\mu$ m 以内, 产品缺陷可控制在 5.0 μ m 以内。	G5.5 及以下 Metal Mesh 触控用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
9	产 品 制 造 技术	带 AF 防护膜层的掩膜版制造技术	产品具有防指纹、耐划伤等功能, 具有疏水性, 水滴角可达 115°及以上。	触控、线路板、LED 等行业用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
10	核 心 工 艺 技术	掩膜版光阻涂布技术	可实现不同粘度、对比度、敏感度及膜厚要求的光阻涂布, 1) 光阻涂布膜厚均匀性可控制在 3.0%以内; 2) 控制涂布过程中的流量、间隙、转速、气压等, 消除涂布后因光阻不均匀造成的色差, 达到控制涂布 Mura 的目的。	应用于 G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版的光阻涂布	自主研发	已获得专利保护
11	核 心 工 艺 技术	掩膜版涂布洗边 (EBR) 控制技术	采用高纯度有机溶液, 通过调整 Nozzle 角度、喷洒状态等, 可对不同粘度、膜厚的光阻进行洗边 (EBR) 处理, 实现不同范围内的光阻洗边。	应用于 G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版的光阻涂布洗边	自主研发	已获得专利保护
12	核 心 工 艺 技术	掩膜版图档防静电处理技术	通过分析掩膜版图形线路电学特性, 针对性进行图档设计优化处理, 从而有效避免	LCD/TP/TFT 用掩膜版的	自主	已获得专

序号	划分维度	核心技术	技术内容	在主要产品中的应用情况	技术来源	知识产权保护情况
	技术		因设计原因造成的掩膜版静电击伤现象，提高了掩膜版品质及使用寿命。	生产	研发	利保护
13	核心技术	DCM 补偿光刻技术	针对面板制造中由于投影光刻过程造成的图形 Distortion，通过相关算法对掩膜版设计图档进行光刻参数补偿，从而实现掩膜版图形与面板投影曝光的整体匹配。	G11 及以下平板显示掩膜版	自主研发	未单独申请专利
14	核心技术	多次对位光刻技术	针对多膜层结构掩膜版，开发多次对位光刻技术，实现不同膜层图形套合精度的要求。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
15	核心技术	掩膜版显影过程中缺陷控制技术	自主开发用于掩膜版显影过程的浸润液，运用该浸润液可保证掩膜版在显影过程中表面无气泡产生，出现气泡的比率从目前的 10%降低到 0%，提升了产品品质。	G6 及以下尺寸掩膜版	自主研发	未单独申请专利
16	核心技术	显影后精度补偿技术	针对掩膜版蚀刻后精度偏差问题，自主开发显影后精度补偿技术，极大提高蚀刻后图形线条质量，减小图形的精度误差。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
17	核心技术	掩膜版高效清洗技术	自主开发针对掩膜版表面有机异物的清洗技术，利用光学手段并结合化学方法，针对性去除掩膜版表面的有机杂质和异物。与传统单一化学清洗方式相比，极大提高了有机杂质和异物的清洗效率。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	已获得专利保护
18	核心技术	半色调 (Half-tone)掩膜版沉积式修补技术	采用不同于传统气相化学沉积的方式，可针对不同透过率半色调膜层缺陷进行修补。最小修补图形可达 1 μ m，可实现 10%到 60%透过率范围膜层修补，修补膜层透过率均匀性可控制在 2%以内。	G11 及以下平板显示用半色调掩膜版	自主研发	未单独申请专利
19	核心技术	掩膜版贴膜后缺陷处理技术	针对掩膜版贴膜过程中造成的异物缺陷，自主开发贴膜后缺陷处理技术，运用激光处理的方式，可实现掩膜版贴膜后异物性缺陷的去除，处理效率高。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
20	核心技术	掩膜版光学膜贴附技术	自主开发掩膜版光学膜贴附技术，结合自主开发的自动、半自动装置，可将贴附精度控制在 ± 0.5 mm 以内，效率高、品质优异。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	已获得专利保护
21	核心技术	高世代掩膜版用包装材料清洗技术	自主开发化学清洗药液及自动化装置，形成高效自动化清洗工艺，能在短时间内进行有效清洗，满足平板显示掩膜版产品包装洁净度、防静电等品质要求。	G11 及以下平板显示掩膜版包装材料的清洗	自主研发	已获得专利保护
22	核心技术	衰减型相移掩膜版 (ATT PSM) 工艺技术	自主开发相移掩膜版工艺技术，可用以实现嵌入式单层式衰减型相移掩膜版的制造；使用该类掩膜版曝光时，光在图形边界处的相位角相差 180°（误差在 $\pm 2^\circ$ 以内），出现光的相消叠加，最终使得客户端的光刻分辨率有所提高。	180nm 及以下节点半导体用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
23	核心技术	高精度半导体掩膜版光阻涂布技术	可实现不同精度要求的半导体用掩膜版的光阻涂布、不同光阻涂布膜厚的控制；涂布均匀性可控制在 1.0%以内，可满足不同粘度、感光性光阻的涂布要求。	半导体用掩膜版	自主研发	已获得专利保护
24	产品制造技术	980*1550 TFT Array 掩膜版制造技术	通过开发对应涂布、光刻、制程、清洗等工艺，实现 980*1550 TFT 掩膜版的制造。针对图形尺寸精度、总长精度、图形套合精度控制等方面进行开发研究，实现产品 CD 精度 $\pm 0.1\mu$ m，位置精度 $\pm 0.3\mu$ m。	980*1550 TFT Array 显示面板用掩膜版	自主研发	未单独申请专利

序号	划分维度	核心技术	技术内容	在主要产品中的应用情况	技术来源	知识产权保护情况
25	核 心 工 艺 技术	新型掩膜版缺陷修复技术	开发掩膜版显影后缺陷修复技术，避免产品蚀刻后出现大尺寸缺陷，降低 CVD 修复风险，提高产品制造良率，缺陷修复面积可达 200 μm 以上。	LCD/TP/TFT 用掩膜版的生产	自主研发	未单独申请专利
26	核 心 工 艺 技术	半导体掩膜版贴膜缺陷控制技术	开发新型半导体掩膜版贴膜工艺及流程，降低 Particle 对贴膜成功造成的影响，提高产品贴膜良率及品质。	半 导 体 用 掩膜版	自主研发	已获得专利保护
27	核 心 工 艺 技术	混版图形 Mura 控制技术	通过研究混版间距、曝光及制程参数对混版图形位置精度的影响，结合图形重新设计排布，开发混版图形 Mura 控制技术，实现不同混版图形的 Mura 要求。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
28	产 品 制 造 技术	下置型半色调 (Half-tone) 掩膜版制造技术	开发新型下置型半色调 (Half-tone) 掩膜版制造技术，可实现二元图形和半色调图形的一次制作，CD 精度可控制在 $\pm 0.10\mu\text{m}$ 以内；两层图形之间套合偏差可控制在 $\pm 0.3\mu\text{m}$ 以内。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	正在申请专利
29	产 品 制 造 技术	980*1150 TFT Array 掩膜版制造技术	通过开发对应涂布、光刻、制程、清洗等工艺，实现 980*1150 TFT 掩膜版的制造。针对图形尺寸精度、总长精度、图形套合精度控制等方面进行开发研究，实现产品 CD 精度 $\pm 0.1\mu\text{m}$ ，位置精度 $\pm 0.3\mu\text{m}$ 。	980*1150 TFT Array 显示面板用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
30	核 心 工 艺 技术	高 PPI AMOLED 显示面板掩膜版 OPC 光刻补偿技术	开发应用于 G6 及以下 AMOLED 显示面板用掩膜版产品的 OPC 光刻补偿技术，使其中高 PPI 类产品的复杂图形以及更锐利的尖角可以有良好的制作效果。	G6 及 以 下 AMOLED 显示面板用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
31	核 心 工 艺 技术	高 PPI AMOLED 显示面板掩膜版缺陷检查技术	通过优化自动扫描设备逻辑与算法，实现高 PPI AMOLED 显示面板用掩膜版产品中 CH 图形缺陷检查，检出能力可达 0.5 μm 。	G6 及 以 下 AMOLED 显示面板用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
32	产 品 制 造 技术	高精度 G8.5 灰阶掩膜版制造技术	通过研究光阻涂布、光刻及化学制程等关键工艺，开发 G8.5 灰阶掩膜版制造技术，实现产品光阻涂布膜厚达到 5000A，均匀性可达到 1.5% 以内；产品 CD 精度灰阶区域可达 $\pm 0.1\mu\text{m}$ ；图形修补精度可达 $\pm 0.15\mu\text{m}$ 。	G8.5 及 以 下显示面板用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
33	核 心 工 艺 技术	半导体掩膜版精细化光刻控制技术	通过控制及调整优化 overlap 区域能量，优化像素能级分布，针对不同厚度膜层优化 Defocus 补偿，实现精细化控制光刻过程，将图形 local CD 精度控制在 20nm 内。	半 导 体 用 掩膜版	自主研发	未单独申请专利
34	核 心 工 艺 技术	半导体掩膜版防霉变清洗包装技术	通过研究不同基板材质特性及半导体掩膜版霉变影响因素，从环境温湿度、保护气体填充、包装前的清洗干燥工艺控制、包装箱体设计等多方面因素出发，开发针对性的清洗包装方式及制具，改善半导体掩膜版霉变现象，延长产品使用寿命。	半 导 体 用 掩膜版	自主研发	已获得专利保护
35	核 心 工 艺 技术	半导体掩膜版 Mura 检查技术	根据半导体掩膜版产品的图形设计及制作工艺差异，开发半导体掩膜版 Mura 检查专用工具及检查工艺，通过此技术可以检查出普通肉眼无法分辨出的 Mura。	半 导 体 用 掩膜版	自主研发	正在申请专利
36	产 品 制 造 技术	硅基 OLED 用掩膜版制造技术	通过开发对应涂布、光刻、制程、清洗等工艺，实现硅基 OLED 用掩膜版产品开发，线/间 (CD) 精度可控制在 $\pm 0.07\mu\text{m}$ 以内，总长 (TP) 精度可以控制在 $\pm 0.15\mu\text{m}$	半 导 体 用 掩膜版	自主研发	未单独申请专利

序号	划分维度	核心技术	技术内容	在主要产品中的应用情况	技术来源	知识产权保护情况
			以内,产品缺陷尺寸可控制在 0.7 μ m 以内,同时产品无 Mura。			
37	产 品 制 造 技术	G6 及 以 下 FMM 用掩模版制造技术	开发产品制造中的扫描技术、基板镀膜前后清洗技术、图形缺陷处理技术;产品图形精度可达 $\pm 0.5\mu$ m,表面水滴角可 $> 100^\circ$,产品表面无 Mura。	G6 及 以 下 FMM 用掩模版	自主研发	未单独申请专利
38	产 品 制 造 技术	Mosi 系 双 层 PSM 掩模版制造技术	开发产品制造中 Mosi 系膜层蚀刻技术、双层 PSM 图形修复技术;产品透过率精度可达 $\pm 0.5\%$, range $< 0.8\%$,相移角精度可达 $\pm 5^\circ$ 。	G11 及以下平板显示掩模版/半导体掩模版	自主研发	正在申请专利
39	产 品 制 造 技术	PSO 掩模版制造技术	开发 PSM+OPC 相结合的产品蚀刻技术、清洗技术、图形修复技术;最小图形 0.5 μ m 可以有良好的制作效果,产品精度可达 $\pm 0.1\mu$ m	G11 及以下平板显示掩模版/半导体掩模版	自主研发	未单独申请专利
40	核 心 工 艺 技术	半导体掩模版 Min Contact Hole 圆弧形貌优化技术	开发半导体掩模版光刻图形处理补偿技术,改善极限方孔直角制作效果;1.5 μ m 方孔图形精度可达 $\pm 0.1\mu$ m。	半 导 体 用 掩 模版	自主研发	未单独申请专利
41	产 品 制 造 技术	Metal Mesh 用 PSM 掩模版制造技术	开发产品制造中的光阻涂布、二次对位光刻、相移层清洗、相移层缺陷处理技术;产品图形精度可达 $\pm 0.1\mu$ m,二次对位精度可达 $\pm 0.3\mu$ m。	G5.5 及以下 Metal Mesh 触控用掩模版	自主研发	未单独申请专利
42	核 心 工 艺 技术	红外传感用掩模版条纹控制技术	针对红外传感掩模版图形设计进行研究,找到不同 pitch 设计对条纹影响的规律,对应开发针对性的条纹控制技术,实现高 PPI 红外传感掩模版条纹的明显改善。	半 导 体 用 掩 模版	自主研发	未单独申请专利
43	产 品 制 造 技术	高精度 LTPO 掩模版制造技术	通过开发对应涂布、光刻、制程、清洗等工艺,实现应用于 LTPO 显示技术的掩模版产品制造,产品尺寸可达 850*1200mm, CD 精度 $\pm 0.07\mu$ m,位置精度 $\pm 0.3\mu$ m	G6 及 以 下 LTPO 掩模版	自主研发	未单独申请专利
44	核 心 工 艺 技术	半导体掩模版光学膜膜面缺陷去除技术	开发半导体掩模版贴膜后检查专用工具及检查工艺,并针对掩模版光学膜表面异物开发去除工艺,提升贴膜半导体掩模版产品制作良率	半 导 体 用 掩 模版	自主研发	未单独申请专利
45	核 心 工 艺 技术	大尺寸掩模版光阻涂布缺陷控制技术	开发针对大尺寸 AMOLED 掩模版产品的光阻涂布缺陷控制技术,并研究开发涂布头相应的清洁与保护系统,使大尺寸掩模版的缺陷密度 $\leq 0.003\text{ea}/\text{cm}^2$,缺陷尺寸小于 10 μ m	平 板 显 示 掩 模版	自主研发	正在申请专利
46	产 品 制 造 技术	3D 玻璃盖板掩模版制造技术	开发应用于 3D 玻璃盖板的掩模版产品制造技术,提升复杂及大数据量资料的处理效率,并且将产品缺陷控制在 1 μ m 以内	半 导 体 用 掩 模版	自主研发	未单独申请专利
47	核 心 工 艺 技术	大尺寸 IC 掩模版套刻精度控制技术	开发用于大尺寸 IC 掩模版的套刻精度校正与量测技术,进而控制和提升大尺寸 IC 掩模版的位置精度和套刻精度。最大覆盖产品尺寸达 228*228mm,套刻精度 $\leq 0.1\mu$ m,量测重复精度小于 15nm	半 导 体 用 掩 模版	自主研发	未单独申请专利
48	核 心 工 艺 技术	大尺寸 FMM 图形形变预补偿技术	开发用于 G6 代 FMM 图形设计制作的形变预补偿技术,实现 FMM 图形拉伸变形局部位置的精度提前预补偿,保障 FMM 使用过程中的套刻精度准确性,在光掩模版上实现 $\leq 0.5\mu$ m 的位置精度偏移	平 板 显 示 掩 模版	自主研发	未单独申请专利

序号	划分维度	核心技术	技术内容	在主要产品中的应用情况	技术来源	知识产权保护情况
49	核心技术	光刻机信号识别与对接技术	根据设备及产品特点，实现 AGV 直接对接光刻机，并实现掩膜版自动上下版	平板显示掩膜版	自主研发	已获得专利保护
50	核心技术	高精度产品脱膜清洗缺陷控制技术	通过研究化学药液对石英表面特性的影响，掌握各种工艺条件下掩膜版表面形貌变化和有机物脏污、颗粒物数量对比差异，提高脱膜清洗过程缺陷的可控性	平板显示掩膜版	自主研发	未单独申请专利
51	核心技术	基于混沌理论的视觉水印模糊技术	针对套刻产品，开发相应的视觉处理系统，提高二次对位的准确性和稳定性，使二次曝光对位精度可达 $\pm 0.2\mu\text{m}$	平板显示掩膜版	自主研发	未单独申请专利
52	核心技术	电感耦合高密度等离子体蚀刻技术	针对半导体掩膜版产品，开发基于电感耦合高密度等离子体的刻蚀技术，刻蚀均匀性可控制在 1% 以内，Taper Angle 大于 85° ，满足 130nm 节点及以下产品要求。	半导体用掩膜版	自主研发	未单独申请专利
53	产品制造技术	像素驱动阵列高精度相移掩膜版量产技术	开发平板显示像素驱动阵列用相移产品技术，涵盖蚀刻、技术、图形修复等核心环节，产品精度可达 $\pm 0.08\mu\text{m}$ ，修补均匀性可达到 1.5% 以内	平板显示掩膜版	自主研发	未单独申请专利
54	核心技术	高精度图形蚀刻形貌控制技术	通过研究化学蚀刻对高精度图形形貌的影响，然后围绕高精度图形蚀刻后形貌优化展开蚀刻工艺开发，能够将图形蚀刻后侧壁形貌控制在合理角度，并且 Side Etch 量控制在 $0.15\mu\text{m}$ 以内。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
55	核心技术	外框 barcode 数据自动化生成技术	开发掩膜版数据条形码自动生成技术，实现快速自动生成对应的条形码内容，降低人员手工输入错误的风险，提升掩膜版图形设计准确率，缩短产品制作周期。	G11 及以下平板显示掩膜版/半导体掩膜版	自主研发	未单独申请专利
56	核心技术	封装行业图形快速处理技术	针对封装行业 ODB++ 的数据文件，开发对应图形处理软件，优化数据处理流程，将图形比对效率稳定提升 45% 以上，从而有效缩短产品制作周期。	半导体用掩膜版	自主研发	未单独申请专利

（二）2026 年上半年，公司获得的研发成果

公司始终将技术创新视为驱动发展的核心引擎。围绕掩膜版制造的关键工艺与下游技术迭代方向，公司构建了“技术突破—精度跃升—产品扩展—前沿储备”四位一体的研发推进体系。在工艺技术端，持续深挖光刻、刻蚀等核心制程的迭代空间；在精度端，向更窄线宽、更优均匀性发起攻关；在产品端，加速高附加值品类的量产导入与全世代覆盖；在储备端，前瞻布局面向下一代显示与半导体技术的掩膜版方案。四维协同发力，使公司在技术演进的道路上持续收获阶段性研发成果。

2026 年 1-6 月，公司完成了多项技术研发项目。“化学蚀刻对高精度图形形貌的影响研究与蚀刻工艺开发”项目通过对高精度图形蚀刻后形貌的研究，制定出更精确的蚀刻工艺参数，进而达到更精确的 CD（关键尺寸）控制能力，提升

MASK 精度等级，更好地满足下游客户需求，同时显著提升公司在行业中的竞争力。“外框 barcode 数据自动化生成及处理效率提升”项目通过开发外框 barcode 图形坐标计算和生成系统，实现批量自动化设计，提高外框 barcode 图档文件处理效率，从而有效缩短产品制作周期。“封装行业图形处理效率提升”项目针对封装行业 ODB++的数据文件，测试研究图形处理软件，优化数据处理流程，提高封装行业图形处理时效，从而有效缩短产品制作周期。

针对具体产品研发方面，在平板显示领域公司新开展了基于半色调技术的异质导电层同步图形化掩膜产品开发，形成 G8.5、G11 等尺寸产品，配套国内 G8.5 及以上 TFT-LCD、AMOLED 等高精度显示终端；在半导体领域，公司开展了高精度衍射光学元件产品开发等研发项目，通过高精度衍射光学元件产品的逐步国产化，可有效打破海外技术垄断，进一步丰富公司在半导体领域的产品线，助力光电产业链国产化升级。与此同时，在过往研发成果的基础上，公司成功实现 G6、G8.5 等多个尺寸 CF/Array 用 PSM 量产，进一步丰富公司产品种类。

（三）研发支出变化及研发进展

2026 年上半年，公司持续进行研发投入达 2,551.58 万元，同比增加 41.64%，占营业收入比例 3.82%。

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入（元）	25,515,833.05	18,014,989.63	41.64
资本化研发投入（元）	0.00	0.00	0.00
研发投入合计（元）	25,515,833.05	18,014,989.63	41.64
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.82	3.31	增加 0.51 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0.00	0.00	增加 0.00 个百分点

2026 年上半年，公司新增 3 项核心技术，新获发明专利 2 件，实用新型专利 8 件，软件著作权 1 件。累计有效授权发明专利 19 件；实用新型 105 件；软件著作权 34 件。2026 年上半年，公司获得的知识产权具体如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	5	2	52	19
实用新型专利	6	8	142	105
软件著作权	1	1	35	34
其他	0	0	2	2
合计	12	11	231	160

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金基本情况

根据中国证监会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号），公司向不特定对象发行6,150,000张可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的不含税发行费用总计人民币7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元，上述资金已于2025年6月17日全部到位。天职国际对资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2025]32665号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 6 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	61,500.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	784.44
二、募集资金净额	60,715.56
减：	
以前年度已使用金额	48,803.32
本年度使用金额	11,932.52
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-销户转出	14.10
加：	
募集资金利息收入	149.05
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	114.66

注 1：销户转出金额 14.10 万元，系募集资金利息收入；

注 2：本表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

（三）募集资金存储与监管情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
深圳市路维光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	337070100100699908	活期存款	0.00	已注销
深圳市路维光电股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳前海分行	755919401710001	活期存款	0.00	已注销
成都路维光电科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	8110301012800804886	活期存款	114.61	/
厦门路维光电有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	592910510510008	活期存款	0.05	/
合计				114.66	/

路维光电 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》以及《自律监管指引第 11 号》等法律法规和规范性文件的规定，上市公司对募集资金进行了专户存储、管理和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，路维光电实际控制人、董事和高级管理人员持有上市公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职情况	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）
1	杜武兵	董事长、总裁	4,602.5900	782.6542
2	肖青	董事、执行总裁、董事会秘书	1,545.4100	16.0386
3	刘鹏	董事、财务总监	/	50.7644
4	孙政民	董事	/	/
5	梁新清	独立董事	/	/
6	李玉周	独立董事	/	/
7	杨洲	独立董事	/	/

注：以上存在间接持股情况的人员均为通过江苏路维兴投资有限公司间接持有公司股份

上市公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在质押、冻结及减持情况。

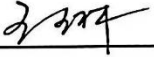
十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


王 琳


张伟权

